## ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

Patent number: JP2002124389

Publication date: 2002-04-26

Inventor: SAKAKIBARA MITSUHIKO;

YASUDA HIROYUKI; NEGORO

YASUNORI

Applicant: JSR CORP; FUTABA DENSHI

KOGYO KK; KOKUSAI KIBAN

ZAIRYO KENKYUSHO

Classification:

- international: C08F12/26; C08F20/34;

C08F20/60; C08F26/06; C09K11/06; H05B33/14; H05B33/22; C08F12/00; C08F20/00; C08F26/00; C09K11/06; H05B33/14;

H05B33/22; (IPC1-7): H05B33/22;

C08F12/26; C08F20/34; C08F20/60; C08F26/06; C09K11/06; H05B33/14

- european:

Application number: JP20000314940 20001016 Priority number(s): JP20000314940 20001016

Report a data error here

Abstract of JP2002124389
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescent element that has low starting voltage of luminance and high luminous efficiency, and is superior in durability. SOLUTION: The organic electroluminescent element comprises a positive hole transport layer that contains a carbazole system polymer having a structure unit as expressed in Formula (I). In the

Formula, R1 expresses hydrogen atom, alkyl group or phenyl group, R2, R3, R4 and R5 each independently expresses hydrogen atom, alkyl group, alkoxyl group, phenyl group or dialkylamino group, and X expresses a single bond or a phenylene group, carbonyl group, or a bivalent organic group containing one or both of these.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号 特開2002-124389

(P2002-124389A) (43)公開日 平成14年4月26日(2002.4.26)

| (51) Int. Cl. ' | 識別記号 |      | FI   |        |    |       | テーマコート・ | (参考) |
|-----------------|------|------|------|--------|----|-------|---------|------|
| H05B 33/22      |      |      | H05B | 33/22  |    | D     | 3K007   |      |
| CO8F 12/26      |      |      | C08F | 12/26  |    |       | 4J100   |      |
| 20/34           |      |      |      | 20/34  |    |       |         |      |
| 20/60           |      |      |      | 20/60  |    |       |         |      |
| 26/06           |      |      |      | 26/06  |    |       |         |      |
|                 |      | 審査請求 | 未請求  | 請求項の数3 | OL | (全15] | 頁) 最終頁  | に続く  |

(21)出願番号 特願2000-314940(P2000-314940) (71)出願人 000004178

(22)出願日 平成12年10月16日(2000.10.16)

ジェイエスアール株式会社 東京都中央区築地2丁目11番24号

(71)出願人 000201814 双葉電子工業株式会社

双葉電子工業株式会社 千葉県茂原市大芝629

(71)出願人 597114270

株式会社国際基盤材料研究所

神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号

(74)代理人 100078754

弁理士 大井 正彦

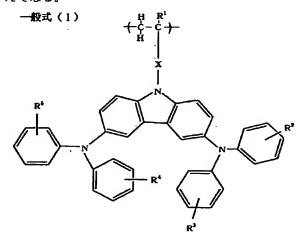
最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】有機エレクトロルミネッセンス素子

### (57)【要約】 (修正有)

【課題】 発光開始電圧が低く、発光効率が高く、しかも、耐久性に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子を提供する。

【解決手段】 一般式(1)で表される構造単位を有するカルバゾール系重合体を含有してなる正孔輸送層を具えてなる。



 $\{R' \mid kt$  表原子、アルキル基またはフェニル基、  $R' \mid R' \mid R' \mid kt$  および  $R' \mid kt$  なんでれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、フェニル基またはジアルキルアミノ基、 X は、単結合、あるいはフェニレン 基、カルボニル基またはこれらの一方若しくは両方を含有する 2 価の有機基を示す。  $\}$ 

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で表される構造単位を 有するカルバゾール系重合体を含有してなる正孔輸送層

を具えてなることを特徴とする有機エレクトロルミネッ センス素子。

#### 【化1】

[式中、R'は水素原子、アルキル基またはフェニル基 20 を示し、R'、R'、R' およびR' は、それぞれ独立 に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、フェニル基ま たはジアルキルアミノ基を示す。Xは、単結合、あるい はフェニレン基、カルボニル基またはこれらの一方若し くは両方を含有する2価の有機基を示す。〕

【請求項2】 カルバゾール系重合体は、一般式(1) で表される構造単位を5質量%以上含有することを特徴 とする請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス 素子。

構造単位を有するカルパゾール系重合体と、当該カルバ ゾール系重合体以外の重合体とを含有してなり、当該正 孔輸送層を構成する全重合体における一般式(1)で表 される構造単位の割合が5質量%以上であることを特徴 とする請求項1または請求項2に記載の有機エレクトロ ルミネッセンス案子。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機エレクトロル ミネッセンス案子に関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年、エレクトロルミネッセンス素子を 構成する正孔輸送材料や電子輸送材料として、有機材料 が使用され始めており、このような有機材料を使用した 有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、「有機EL 案子」ともいう。) の研究が活発に行われている。かか る有機EL案子を構成する有機材料においては、優れた 耐久性を有するものであること、高い発光効率が得られ るものであることが要求される。

【0003】従来、正孔輸送性能を有する有機材料とし ては、ジアミン誘導体、N、N'ージフェニルーN,  $N' - \mathcal{Y}(3 - \mathcal{Y} + \mathcal{Y} + \mathcal{Y}) - 4, 4', \mathcal{Y} + \mathcal{Y} +$ ピフェニル(以下、「m-TPD」ともいう。)などの 芳香族アミン系化合物などの低分子有機材料、ポリビニ ルカルバゾールなどの高分子有機材料が知られている。 然るに、上記の低分子有機材料は、物理的または熱的な 耐久性に乏しいものであるため、当該低分子有機材料に より正孔輸送層を構成する場合には、有機EL素子の駆 動中または保存中に当該正孔輸送層が変質してしまう、 【請求項3】 正孔輸送層は、一般式 (1) で表される 30 という欠点がある。また、ポリビニルカルバゾールなど の高分子有機材料は、ガラス転移点 (Tg) が非常に高 いものであるので、優れた耐久性、すなわち長い使用寿 命を有する正孔輸送層が得られるが、発光開始電圧が非 常に高く、また、正孔輸送性能が十分なものではないた めに発光効率が低く、実用上問題がある。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、以上のよう な事情に基づいてなされたものであって、その目的は、 発光開始電圧が低く、発光効率が高く、しかも、耐久性 40 に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子を提供する ことにある。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明の有機エレクトロ ルミネッセンス案子は、下記一般式(1)で表される構 造単位を有するカルパゾール系重合体を含有してなる正 孔輸送層を具えてなることを特徴とする。

[0006]

【化2】

【0007】〔式中、R'は水素原子、アルキル基また はフェニル基を示し、R'、R'、R'およびR'は、 それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、 フェニル基またはジアルキルアミノ基を示す。Xは、単 20 位」という。)を有するカルバゾール系重合体(以下、 結合、あるいはフェニレン基、カルポニル基またはこれ らの一方若しくは両方を含有する2価の有機基を示 す。)

【0008】本説明の有機エレクトロルミネッセンス素 子においては、前記カルパゾール系重合体は、上記一般 式(1)で表される構造単位を5質量%以上含有するこ とが好ましい。また、前記正孔輸送層は、上記一般式 (1) で表される構造単位を有するカルバゾール系重合 体と、当該カルバゾール系重合体以外の重合体とを含有 してなるものである場合には、当該正孔輸送層を構成す 30 る全重合体における一般式(1)で表される構造単位の 割合が5質量%以上であることが好ましい。また、本発 明の有機エレクトロルミネッセンス素子は、少なくとも 陽極層と、前記正孔輸送層と、発光層と、陰極層とを有 することが好ましい。

#### [0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。図1は、本発明の第1の実施の形態に係る有機工 レクトロルミネッセンス素子の構成を示す説明用断面図 である。この有機EL素子においては、透明基板1上 に、陽極層(ホール注入電極層) 2が設けられ、この陽 極層2上には、正孔輸送層10が設けられ、この正孔輸 送層10上には、発光層15が設けられ、この発光層1 5上には、陰極層(電子注入電極層) 3 が設けられてい る。そして、陽極層2および陰極層3は直流電源5に接 統されている。

【0010】透明基板1としては、ガラス基板、透明性 樹脂基板、石英ガラス基板などを用いることができる。 陽極層2としては、仕事関数の大きい(例えば4 e V以

nO<sub>1</sub>) 膜、酸化銅(CuO) 膜、酸化亜鉛(ZnO) 膜などを用いることができる。正孔輸送層10は、上記 一般式(1)で表される構造単位(以下、「特定構造単 「特定のカルバゾール系重合体」ともいう。) を含有し てなるものである。

【0011】特定構造単位を示す一般式(1)におい て、R'は水素原子、アルキル基またはフェニル基を示 す。ここで、アルキル基の具体例としては、メチル基、 エチル基、プロピル基、プチル基、ヘキシル基、オクチ ル基、ドデシル基などの炭素数1~18のアルキル基が 挙げられる。そして、一般式 (1) においてR' として は、メチル基、エチル基などの炭素数1~3のアルキル 基、水素原子が好ましい。

【0012】また、一般式(1)におけるR'、R'、 R'およびR'は、水素原子、アルキル基、アルコキシ 基、フェニル基またはジアルキルアミノ基を示し、全部 が同一のものであっても、その一部または全部が異なっ たものであってもよい。ここで、アルキル基としては、 特に限定されるものではないが、メチル基、エチル基、 プロピル基、ブチル基、ヘキシル基、オクチル基などの 炭素数が1~8のアルキル基が好ましい。特に、高い正 孔輸送性能が得られる点では、メチル基が好ましく、有 機溶剤に対して高い溶解性を有する重合体が得られる点 では、炭素数が大きい(例えば炭素数が8)アルキル基 が好ましい。アルコキシ基としては、特に限定されるも のではないが、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ 基、プトキシ基などの炭素数が1~8のアルコキシ基が 好ましく、特に、高い正孔輸送性能が得られる点では、 メトキシ基が好ましい。ジアルキルアミノ基としては、 特に限定されるものではないが、ジメチルアミノ基、ジ エチルアミノ基、ジプロピルアミノ基などの炭素数が1 ~8のアルキル基を有するものが好ましく、特に、高い 上)材料よりなるもの、例えばITO膜、酸化スズ(S 50 正孔輸送性能が得られる点では、ジーnープロピルアミ

ノ基、ジーiープロピルアミノ基が好ましい。そして、 一般式(1)において、R'およびR'の組み合わせと しては、両者のいずれか一方が水素原子であって、他方 がアルキル基であるもの、またR'およびR'の組み合 わせとしては、両者のいずれか一方が水素原子であっ て、他方がアルキル基であるものが好ましい。また、R '~R'の各々が、水素原子以外のものである場合に は、それぞれの位置はメタ位またはパラ位であることが 好ましい。

【0013】一般式(1)においてXは、単結合、ある 10 いはフェニレン基、カルボニル基またはこれらの一方若 しくは両方を含有する2価の有機基を示す。カルポニル 基を含有する2価の有機基としては、例えば-COO-で表される基(オキシカルポニル基)、-CONH-で 表される基(イミノカルボニル基)または-CONHC 〇-で表される基(ウレイレン基)が挙げられる。フェ ニレン基を含有する2価の有機基としては、例えば-C , H, CH, O-で表される基が挙げられる。また、カ ルポニル基およびフェニレン基の両方を含有する2価の たは下記式(ロ)で表される基が挙げられる。ここで、 フェニレン基およびこれを含有する2価の有機基は、o -体、m-体、p-体のいずれであってもよいが、p-体であることが好ましい。そして、一般式(1)におい てXとしては、式(イ)で表される基、式(ロ)で表さ れる基、フェニレン基が好ましい。

[0014]

[化3]

6

[0015] [化4]

式 (口)

$$-C-O-(CH_2)_n-N-C-N-$$

【0016】 (式(ロ) において、繰り返し数nは、1・ ~10の整数である。}

【0017】このような特定構造単位は、下記一般式 (2) で表されるカルパゾール誘導体(以下、「特定単 有機基としては、例えば下記式(イ)で表される基、ま 20 量体」ともいう。)から得られるものであり、かかる特 定単量体の好ましい具体例としては、例えば下記式 (a) で表されるもの、下記式 (b) で表されるもの、 下記式(c)で表されるものおよび下記式(d)で表さ れるものなどが挙げられる。

> [0018] 【化5】

【0019】 (式中、R' は水素原子、アルキル基また はフェニル基を示し、R'、R'、R'およびR'は、 それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、 フェニル基またはジアルキルアミノ基を示す。 Xは、単 結合、あるいはフェニレン基、カルボニル基またはこれ らの一方若しくは両方を含有する2価の有機基を示 す。)

[0020]

[化6]

[0021] [化7] 【0022】このような特定単量体は、例えばカルバソールを出発物質として、当該カルバゾールの窒素に結合する水素原子並びに3および6の位置番号の各炭素原子に結合する水素原子に対して種々の置換反応を行うことにより得られる。具体的な一例として、上記式(a)で表されるカルバゾール誘導体の製造方法を説明すると、先ず、カルバゾールに、例えばニトロベンゼンを反応させることにより、当該カルバゾールの窒素に結合する水素原子をニトロフェニル基に置換し、さらに、例えば臭素を反応させることにより、3および6の位置番号の各炭素原子に結合する水素原子を臭素原子に置換し、これにより、中間生成物(A)(3.6ージブロム[N-

40 (p-二トロフェニル) カルパゾール]) を得る。この 合成工程を、反応式(i)に示す。

[0023]

【化8】

反応式(i)

9 Н C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NO<sub>2</sub> ŅO₂ Brz NOz 中間生成物 (A)

【0024】このようにして得られる中間生成物(A) に、例えばm-トリルフェニルアミンを反応させること により、臭素原子をトリルフェニルアミノ基に置換する ことにより中間生成物 (B) (3,6-ピス(m-トリ ルフェニルアミノ) [N-(p-ニトロフェニル) カル バゾール]) を得、更に、例えば中間生成物(B)に対 して水素添加反応を行うことにより、ニトロ基をアミノ 基に変換し、中間生成物(C)(3,6-ピス(m-ト リルフェニルアミノ) [N-(p-アミノフェニル) カ 10 ルバゾール]) を得る。この合成工程を、反応式 (ii) および反応式 (iii ) に示す。

[0025] 【化9】

[0026]

( )

【0027】そして、得られる中間生成物(C)に、例えばメタクリロイルクロライドを反応させることにより、式(a)で表されるカルパゾール誘導体を製造することができる。

【0028】また、式(b)で表されるカルバゾール誘導体を製造する方法を説明すると、上記式(a)で表されるカルバゾール誘導体の製造方法と同様にして、カルバゾールを出発物質として上記中間生成物(C)を合成40し、当該中間生成物(C)に、例えば2-イソシアナートエチルメタクリレートを反応させることにより、式(b)で表されるカルバゾール誘導体を製造することができる。

【0029】特定のカルバゾール系重合体は、特定構造単位のみよりなるもの、すなわち特定単量体の単独重合体であっても、特定構造単位と他の構造単位とを有するもの、すなわち特定単量体と、これと共重合可能な単量体(以下、「共重合性単量体」という。)との共重合体であってもよい。

【0030】特定のカルバゾール系重合体が、特定単量体と共重合性単量体との共重合体である場合には、特定構造単位の含有割合が5質量%以上、特に10質量%以上であることが好ましい。特定構造単位の含有割合が5質量%未満である場合には、得られる正孔輸送層10は、正孔輸送性能および耐久性が低いものとなりやすい。

40 【0031】かかる共重合性単量体としては、例えばNーピニルカルバゾール、Nー(4ーピニルフェニル)カルバゾール、Nーピフェニルピニルカルバゾールなどの特定単量体以外のカルバゾール誘導体、下記式(e)で表される化合物、下記式(f)で表される化合物、下記式(g)で表される化合物などのピニル芳香族アミン類、pーピニルトリフェニルアミン、pーメタクリロイルトリフェニルアミンなどの正孔輸送能を有する単量体を挙げることができ、特にNーピニルカルバゾールが好ましい。これらの共重合性単量体は、1種単独でまたは50 2種以上を組み合わせて用いることができる。

[0032]

【化11】

【0033】特定のカルバゾール系重合体の重量平均分子量は、例えばゲルバーミエーションクロマトグラフ法によるポリスチレン換算で1000~100000、特に5000~30000であることが好ましい。この重量平均分子量が1000未満である場合には、当該重合体が耐熱性、薄膜状態における安定性および機械的強度が不十分なものとなることがある。一方、この重量平均分子量が100000を超える場合には、当該重合体はその溶液粘度が著しく高いものとなりやすく、正孔輸送層10を湿式法により形成する際に、ハンドリング性が低下し、また、正孔輸送層形成溶液の糸引き性が生じるため、好ましくない。また、重量平均分子量との比Mw/Mnは、特に限定されるものではないが、分子量のそろった重合体、すなわち比Mw/Mnが比較的小さいものが好ましい。

【0034】特定のカルパソール系重合体は、特定単量体または特定単量体と共重合性単量体との混合単量体を、適宜の重合法、例えばラジカル重合法、アニオン重合法またはカチオン重合法で重合することにより製造することができる。また、分子量分布の狭いカルパソール系重合体を得るためには、リピングラジカル重合法、リビングアニオン重合法またはリビングカチオン重合法が用いられる。

【0035】通常のラジカル重合法によって特定のカルパゾール系重合体を得る場合には、アゾビスイソブチロニトリル (AIBN) などのアゾ化合物、過酸化ベンゾイル (BPO) などの過酸化物、テトラエチルチウラムジスルフィドなどのジチオカルバメート誘導体などの公知のラジカル開始剤を重合触媒として用いたラジカル重6法を利用することができる。また、リビングラジカル

()

17

重合法によって特定のカルバゾール系重合体を得る場合 には、2, 2, 6, 6-テトラメチル-1-ピペリジン -N-オキサイド (TEMPO) などのN-オキシラジ カルと、上記のラジカル重合開始剤とを組み合わせた触 媒系によるリビングラジカル重合法、アトムトランスフ ァー重合などによるリピングラジカル重合法を利用する ことができる。このようなラジカル重合触媒の使用割合 は、単量体1モルに対して1~0.0001モルであ る。このようなラジカル重合法において、重合溶媒とし ては、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、 N-メチルピロリドンなどのアミド系溶媒、ベンゼン、 トルエン、キシレン、ヘキサン、シクロヘキサンなどの 炭化水素系溶媒、アープチロラクトン、乳酸エチルなど のエステル系溶媒、シクロヘキシルペンゾフェノン、シ クロヘキサノン、2-エチルペンタノン、エチルイソア ミルケトンなどのケトン系溶媒、テトラヒドロフランな どの環状エーテルやジエチレングリコールジメチルエー テルなどの脂肪族エーテル類などのエーテル系溶媒を用 いることができる。また、反応温度は、例えば0~20 0℃であり、その反応時間は、例えば0.5~72時間 20 たは2種以上を組み合わせて用いることができる。 である。

【0036】通常のアニオン重合法によって特定のカル パゾール系重合体を得る場合には、例えば、ナフチルナ トリウムなどのアルフィン触媒、メチルリチウム、エチ ルリチウム、プチルリチウムなどのアルキルリチウム、 フェニルリチウムなどのアリールリチウム、ジエチル亜 鉛などのアルキル亜鉛、リチウムアルキルマグネシウ ム、リチウムアルキルバリウムなどのアート錯体などの アルカリ金属、アルカリ土類金属などの金属による有機 金属化合物をアニオン重合触媒として用いたアニオン重 30 合法を利用することができる。特に、アニオン重合触媒 としては、n-プチルリチウム、sec-プチルリチウ ム、フェニルリチウムなどの有機リチウム化合物を用い ることが好ましい。また、リビングアニオン重合法によ って特定のカルバゾール系重合体を得る場合には、プチ ルリチウム、エチルリチウム、エチルナトリウムなどの 触媒によるリビングアニオン重合法を利用することがで きる。このようなアニオン重合触媒の使用割合は、単量 体1モルに対して1.0~0.001モルである。こ のようなアニオン重合法において、重合溶媒としては、 ベンゼン、トルエン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキ サンなどの炭化水素、テトラヒドロフラン、ジオキサン などのエーテル化合物などを用いることができる。ま た、反応温度は、例えば-50~100℃であり、その 反応時間は、例えば0.25~48時間である。

【0037】通常のカチオン重合法によって特定のカル バゾール系重合体を得る場合においては、トリフルオロ ボレート、四塩化錫などのルイス酸、硫酸、塩酸などの 無機酸、カチオン交換樹脂などの公知のカチオン重合触 媒を用いたカチオン重合法を利用することができる。ま 50

た、リピングカチオン重合法によって特定のカルパゾー ル系重合体を得る場合には、HI、HI-ZnI、など の触媒によるリビングカチオン重合法を利用することが できる。このようなカチオン重合触媒の使用割合は、単 量体1モルに対して0.01~0.00001モルであ る。このようなカチオン重合法において、重合溶媒とし ては、メチレンクロライド、クロロベンゼンなどに代表 されるハロゲン化炭化水素類、ジブチルエーテル、ジフ ェニルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランなど の環状エーテル類、アセトニトリル、ニトロペンゼンな どの高極性溶媒などを用いることができる。また、反応 温度は、例えば-150~50℃であり、その反応時間 は、例えば0.5分~24時間である。

【0038】本発明の有機EL素子においては、正孔輸 送層10は、特定のカルパゾール系重合体のみにより構 成されていても、特定のカルバゾール系重合体と、当該 特定のカルバゾール系重合体以外の重合体(以下、「他 の重合体」という。)とにより構成されていてもよい。 ここで、特定のカルバゾール系重合体は、1種単独でま

【0039】正孔輸送層10を特定のカルバゾール系重 合体と他の重合体とにより形成する場合には、全重合体 における特定構造単位の含有割合が5質量%以上、特に 10質量%以上であることが好ましい。特定構造単位の 含有割合が5質量%未満である場合には、得られる有機 EL素子は、発光開始電圧が高いものとなりやすく、ま た、発光効率が低く、耐久性も低いものとなりやすい。 【0040】正孔輸送層10を構成する他の重合体とし ては、例えばポリビニルカルバゾール、ポリ (4-ビニ ルフェニル)カルバゾール、ポリビニルトリフェニルア ミン、ピニルカルパゾールと2-(4-ピニルフェニ の共重合体などの公知の正孔輸送能を有する重合体など を挙げることができ、好ましくはポリ (4-ビニルフェ ニル)カルパゾール、ポリピニルトリフェニルアミン、 ピニルカルバゾールと2-(4-ピニルフェニル)-5 -ナフチル-1.3,5-オキサジアゾールとの共重合 体を挙げることができる。これらの他の重合体は、1種 単独でまたは2種以上を組み合わせて用いることができ 40 る。

【0041】また、正孔輸送層10には、種々の染料、 レーザー色素などが含有されていてもよく、その割合 は、正孔輸送層10を構成する全材料の0.1~10質 **量%であることが好ましい。このような染料、レーザー** 色素などが正孔輸送層10中に含有されることにより、 得られる有機EL素子は、発光が促進されると共に、一 **層長い使用寿命を有するものとなる。** 

【0042】発光層15を構成する発光材料としては、 トリスキノリノラートアルミナムに代表されるヒドロキ シキノリンの金属錯化物や、ヒドロキシベンズオキサゾ

ール、ヒドロキシベンズチアゾールの金属錯化物などを用いることができる。陰極層3としては、仕事関数の小さい(例えば4 e V以下)材料よりなるもの、例えばアルミニウム、カルシウム、マグネシウム、リチウム、インジウム等よりなる金属膜、またはこれらの金属の合金膜、またはこれらの金属と他の金属との合金膜などを用いることができる。正孔輸送層10および発光層15の各々の厚みは、特に限定されるものではないが、通常、10~1000nm、好ましくは50~200nmの範囲で選択される。

【0043】このような有機EL素子は、例えば以下のようにして製造することができる。先ず、透明基板1の表面に、陽極層2を形成し、この陽極層2の表面に、特定のカルバゾール系重合体および必要に応じて用いられるその他の材料が適宜の有機溶剤中に溶解されてなる正孔輸送層形成溶液を塗布し、得られた塗布膜を加熱処理することにより、当該塗布膜中の有機溶剤が除去されて正孔輸送層10が形成される。次いで、正孔輸送層10の表面に発光層15を形成し、その後、発光層15の表面に陰極層3を形成し、以て、図1に示す構成の有機E20L素子が製造される。

【0044】以上において、陽極層2を形成する方法としては、真空蒸着法またはスパッタ法などを利用することができる。また、ガラス基板などの透明基板の表面に例えばITO膜が形成されてなる市販の材料を用いることもできる。

【0045】正孔輸送層形成溶液を調製するための有機 溶剤としては、正孔輸送層10を形成するための材料 (特定のカルバゾール系重合体および必要に応じて用い られるその他の材料)を溶解し得るものが用いられ、そ 30 の具体例としては、クロロホルム、クロロベンゼン、テ トラクロロエタン等のハロゲン化炭化水素、ジメチルホ ルムアミド、N-メチルピロリドン等のアミド系溶剤、 乳酸エチル、ペグミア、エチルエトキシプロピオネー ト、メチルアミルケトンなどが挙げられる。これらの有 機溶剤は、単独でまたは2種以上を組み合わせて用いる ことができる。 これらの中では、均一な厚みを有する 薄膜が得られる点で、適当な蒸発速度を有するもの、具 体的には沸点が70~150℃程度の有機溶剤を用いる ことが好ましい。有機溶剤の使用割合は、正孔輸送層 1 0を形成するための材料の種類によって異なるが、通 常、正孔輸送層形成溶液中の正孔輸送層10を形成する ための材料の濃度が0.1~10重量%となる割合であ る。また、正孔輸送層形成溶液を塗布する手段として は、例えばスピンコート法、ディッピング法、ロールコ ート法などを利用することができる。

【0046】また、発光層15を形成する方法としては、(1)発光材料を、正孔輸送層10の表面に真空蒸着することにより、発光層15を形成する乾式法、

(2) 発光材料が適宜の有機溶剤中に溶解されてなる発 50

光層形成溶液を、正孔輸送層15の表面に塗布して加熱 処理することにより、発光層15を形成する湿式法など を利用することができる。湿式法を利用する場合におい て、発光層形成溶液を調製するための有機溶剤として は、発光材料を溶解し得るものであれば、種々のものを 用いることができ、その具体例としては、トルエン、キ シレン等の芳香族炭化水素類、メチルイソブチルケト ン、シクロヘキサノン等のケトン類、乳酸エチル、γー プチロラクトン等のエステル類、N-メチルピロリドン 10 等のアミド類、2-エチルヘキサノール等のアルコール 類、テトラクロロエタン等のハロゲン化合物などが挙げ られる。有機溶剤の使用割合は、発光材料の種類によっ て異なるが、通常、発光層形成溶液中の発光材料の濃度 が0.5~10重量%となる割合である。発光層形成溶 液を塗布する手段としては、例えばスピンコート法、デ イッピング法、ロールコート法などを利用することがで きる。また、陰極層3を形成する方法としては、真空蒸 着法またはスパッタリング法などを利用することができ

【0047】上記の第1の実施の形態に係る有機EL素子においては、直流電源5により、陽極層2と陰極層3との間に直流電圧が印加されると、正孔輸送層10および発光層15が発光し、この光は陽極層2およびガラス基板1を介して放射される。このような構成の有機EL素子は、正孔輸送層10が、特定のカルバゾール系重合体を含有してなるため、発光開始電圧が低く、発光効率が高く、しかも、耐久性に優れたものである。

【0048】図2は、本発明の第2の実施の形態に係る 有機EL素子の構成を示す説明用断面図である。この有 機EL素子は、発光層15上に、電子輸送層20が設け られ、この電子輸送層20上に、陰極層3が設けられて いること以外は、第1の実施の形態に係る有機EL素子 と同様の構成である。電子輸送層20を構成する材料と しては、8-ヒドロキシキノリン誘導体等のキノリン系 化合物の金属錯体、ピスナフチルオキサジアゾール、p - t - プチルフェニル - ピフェニル - オキサジアゾー ル、2-ナフチル-5-フェニル-オキサジアゾールな どのオキサジアゾール系化合物、またはこれらの残基を 側鎖に含有するポリマーなどを用いることができる。こ のような電子輸送層20は、真空蒸着法、スパッタ法な どの乾式法、電子輸送材料を適宜の溶剤に溶解した後、 この溶液を、スピンコート法、ディップ法、インクジェ ット法、印刷法等により塗布して乾燥させる湿式法によ り形成することができる。特に、上記の電子輸送材料 と、アルカリ金属若しくはアルカリ土類金属とを共蒸着 することによって、電子輸送層20を形成することが好 ましい。この第2の実施の形態に係る有機EL素子によ れば、前述の第1の実施の形態に係る有機EL素子と同 様の効果が得られる。また、電子輸送層20が形成され ているため、ホール(正孔)の素抜けが防止されると共

に、電子の輸送がスムーズとなり、発光開始電圧が一層 低下し、更に、発光効率の一層の向上を図ることができ

【0049】図3は、本発明の第3の実施の形態に係る 有機EL案子の構成を示す説明用断面図である。この有 機EL素子は、電子輸送層20上に、電子注入層25が 設けられ、この電子注入層25上に、陰極層3が設けら れていること以外は、第2の実施の形態に係る有機EL 素子と同様の構成である。電子注入層25を構成する材 料としては、LiF、MgF,、CsF等の金属フッ化 10 物、A1〇、、SrO等の金属酸化物、アルミニウム等 の金属の錯体などの化合物から、アノードおよび電子輸 送層を構成する材料の仕事関数、LUMOレベルを考慮 して適宜選択することができるこの電子注入層25は、 電子輸送層20の表面全面に形成されていても、当該表 面に点在した状態で形成されていてもよく、また、その 厚みは、0.1~20nm程度でよい。このような電子 注入層25は、真空蒸着法、スパッタ法などの乾式法に より形成することができる。この第3の実施の形態に係 る有機EL素子によれば、前述の第1の実施の形態およ 20 び第2の実施の形態に係る有機EL素子と同様の効果が 得られる。また、電子注入層25が形成されているた め、アノードからの電子の注入がスムーズとなり、発光 開始電圧が一層低下し、更に、発光効率の一層の向上を 図ることができる。

【0050】図4は、本発明の第4の実施の形態に係る 有機EL素子の構成を示す説明用断面図である。この有 機EL素子は、陽極層2上に、正孔注入層30が設けら れ、この正孔注入層30上に、正孔輸送層10が設けら れていること以外は、第1の実施の形態に係る有機EL 素子と同様の構成である。正孔注入層30を構成する材 料としては、銅フタロシアニン、ポリアニリン、ポリチ オフェン、商品名「PEDOT」(パイエル社製)で市 販されているポリエチレンジオキシチオフェンとポリス チレンスルホン酸との錯体などを用いることができる。 このような正孔注入層30は、真空蒸着法、スパッタ法 などの乾式法、電子輸送材料を適宜の溶剤に溶解した 後、この溶液を、スピンコート法、ディップ法、インク ジェット法、印刷法等により塗布して乾燥させる湿式法 により形成することができる。また、その厚みは、1~ 100 nmである。この第4の実施の形態に係る有機 E L素子によれば、前述の第1の実施の形態に係る有機E L素子と同様の効果が得られる。また、正孔注入層30 が形成されているため、ホールの注入障害を防止するこ とができる。

【0051】図5は、本発明の第5の実施の形態に係る 有機EL素子の構成を示す説明用断面図である。この有 機EL素子は、発光層15上に、電子輸送層20が設け られ、この電子輸送層20上に、陰極層3が設けられて いること以外は、第4の実施の形態に係る有機EL素子 50 と同様の構成である。電子輸送層20を構成する材料としては、第2の実施の形態に係る有機EL素子と同様のものを用いることができる。この第5の実施の形態に係る有機EL素子によれば、前述の第1の実施の形態、第2の実施の形態および第4の実施の形態に係る有機EL素子と同様の効果が得られる。

22

【0052】図6は、本発明の第6の実施の形態に係る有機EL素子の構成を示す説明用断面図である。この有機EL素子は、電子輸送層20上に、電子注入層25が設けられ、この電子注入層25上に、陰極層3が設けられていること以外は、第5の実施の形態に係る有機EL素子と同様の構成である。電子注入層25を構成する材料としては、第3の実施の形態に係る有機EL素子と同様のものを用いることができる。この第6の実施の形態に係る有機EL素子によれば、前述の第1の実施の形態~第4の実施の形態に係る有機EL素子と同様の効果が得られる。

[0053]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。なお、以下において、「部」は、「質量部」を意味する。

【0054】 〔カルパゾール誘導体の合成〕

(誘導体合成例1) 還流装置付きのフラスコに、出発物質としてカルバゾール20gと、メタル化剤として水酸化カリウム15gと、ニトロベンゼン80ミリリットルとをこの順で加えて室温で撹拌した後、この系を撹拌しながら1時間かけて80℃に昇温し、さらに80℃で1時間撹拌した後、その系を直ちに90℃に昇温して1.5時間撹拌することにより反応溶液を得た。得られた反応を開して再結晶させることにより、反応生成物15gを回収した。得られた反応生成物は、N-(p-ニトロフェニル)カルバゾール(以下、「化合物(1)」という。)であることが確認された。

【0055】滴下ロート付き3ロフラスコに、化合物 (1) 5gと、酢酸80ミリリットルとを仕込み、化合物 (1) を酢酸に溶解した後、この系に臭素8.2gを室温で滴下して5時間反応させることにより反応溶液を得た。得られた反応溶液を氷水400ミリリットル中に注ぎ、反応生成物を析出して回収し、それをテトラヒドロフラン(THF)に溶解して再結晶することにより、反応生成物7gを得た。得られた反応生成物は、3,6ージプロム [N-(p-ニトロフェニル)カルバゾール] (以下、「化合物(2)」という。)であることが確認された。

【0056】不活性ガスの雰囲気中で還流装置付き3ロフラスコ内において、化合物(2)5gと、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(Pd, (dba),)3100mgと、ナトリウム-t-ブトキシド3gとを、m-キシレン300ミリリットルに溶解さ

せ、これにm-トリルフェニルアミン6.2gと、トリ ス(tープチル)フォスフィン91mgとを添加して室 温で撹拌した後、その系を120℃で2時間加熱するこ とによって反応を行った。反応溶液を高速液体クロマト グラフィー (HPLC) により分析して反応が終了した ことを確認し、当該反応溶液を食塩水で洗浄し、その 後、エーテルによって抽出、次いで脱水・乾燥処理した 後、溶媒を除去し、反応物(固体)を得た。その反応物 をアセトンに溶解させ、メタノールを用いて沈殿精製す ることにより、反応生成物6gを回収した。得られた反 10 応生成物は、3,6-ピス(m-トリルフェニルアミ ノ) [N-(p-ニトロフェニル) カルパゾール] (以 下、「化合物(3)」という。)であることが確認され た。

【0057】加圧反応装置に、化合物(3)5gと、触 媒として10質量%となる量のパラジウムカーボン (パ ラジウム5%担持)とを仕込み、ジメチルホルムアミド (DMF) 溶媒の存在下で水素添加反応させた。その 後、触媒を濾過により分離し、カラムを用いて精製する ことにより、反応生成物を得た。得られた反応生成物 は、3,6-ビス(m-トリルフェニルアミノ)[N-(p-アミノフェニル)カルパゾール] (以下、「化合 物(4)」という。)であることが確認され、その純度 は97%、収率は85%であった。

【0058】化合物(4)3.1gと、メタクリロイル クロライド 0. 53 g とを、当該化合物 (4) の 2 倍の モル量のトリエチルアミン (脱HC1剤) の存在下で反 応させた後、生成したトリエチルアミン塩酸塩および残 存したトリエチルアミンを除去することにより、反応生 成物を得た。得られた反応生成物は、前記式 (a) で表 30 されるカルパゾール誘導体(以下、「誘導体(1)」と いう。) であることが確認された。また、誘導体(1) の収率は85%であった。

【0059】〈誘導体合成例2〉合成例1と同様にして 化合物(4)を合成し、この化合物(4)5gを、滴下 ロート付きフラスコ内においてトルエンに溶かし、この 溶液に2-イソシアナートエチルメタクリレート1.3 gを-70℃で滴下接触させた後、この系の温度を徐々 に30℃に上げて反応を完結させた。なお、この反応は 定量的であった。得られた反応溶液をカラムを用いて分 40 離することにより、反応生成物を得た。得られた反応生 成物は、前記式(b)で表されるカルバゾール誘導体 (以下、「誘導体(2)」という。) であることが確認 された。また、誘導体(2)の純度は98%であった。 【0060】 〔特定のカルパゾール系重合体の合成〕 〈重合体合成例1〉 容積50ミリリットルの耐圧ピンの 内部を窒素ガスで置換した後、この耐圧ピン内に、窒素 気流下で誘導体(1)20ミリモルと、N、N-ジメチ ルホルムアミド10ミリリットルとを仕込み、誘導体 (1)をN、N-ジメチルホルムアミドに溶解させた。

この溶液を攪拌しながら、当該溶液にラジカル重合触媒 としてアゾピスイソブチロニトリル2ミリモルを添加 し、この系を室温から70℃に上昇させて反応温度70 ℃、反応時間18時間の条件でラジカル重合を行うこと により、重合体溶液を得た。得られた重合体溶液を、そ の50倍の量のメタノール中に投入することによって重 合体を凝固させることにより、重合体を回収した。この 重合体を常法により再沈精製し、その後、50℃で1日 間減圧乾燥した。以下、得られた重合体を重合体(A-1) という。得られた重合体(A-1)は、前記式

(a) で表される特定構造単位よりなるカルパソール系 重合体であることが確認された。また、重合体 (A-1) の重量平均分子量Mwは、ゲルパーミエーションク ロマトグラフ法(溶媒:テトラヒドロフラン)によるポ リスチレン換算で、10300であり、重量平均分子量 と数平均分子量との比Mw/Mnは1.5であった。

【0061】 (重合体合成例2) 誘導体 (1) 20ミリ モルの代わりに誘導体(2)20ミリモルを用いたこと 以外は、重合体合成例1と同様にして重合体を得た。以 下、得られた重合体を重合体(A-2)という。得られ た重合体(A-2)は、前記式(b)で表される特定構 造単位よりなるカルバゾール系重合体であることが確認 された。また、重合体(A-2)の重量平均分子量Mw は、ゲルパーミエーションクロマトグラフ法(溶媒:テ トラヒドロフラン) によるポリスチレン換算で、280 00であり、重量平均分子量と数平均分子量との比Mw /Mnは1.65であった。

【0062】〈重合体合成例3〉誘導体(1)20ミリ モルの代わりに誘導体(2)20ミリモルを用い、また N-ピニルカルパゾール20ミリモルを共に用いたこと 以外は、重合体合成例1と同様にして重合体を得た。以 下、得られた重合体を重合体(A-3)という。また、 このカルバゾール系重合体(A-3)は、前記式(b) で表される特定構造単位と、N-ビニルカルパゾールに 由来する構造単位とよりなるカルバゾール系重合体であっ ることが確認された。また、重合体 (A-3) の重量平 均分子量Mwは、ゲルパーミエーションクロマトグラフ 法(溶媒:テトラヒドロフラン)によるポリスチレン換 算で、20000であり、重量平均分子量と数平均分子 量との比Mw/Mnは1.65であった。そして、重合 体(A-3)は、特定構造単位を50質量%含有するも のであった。

【0063】 (重合体合成例4) 誘導体 (1) 20ミリ モルの代わりに誘導体(2)20ミリモルを用い、また 前記式(c)で表される化合物10ミリモルを共に用い たこと以外は、重合体合成例1と同様にして重合体を得 た。以下、得られた重合体を重合体(A-4)という。 また、このカルパゾール系重合体 (A-4) は、前記式 (b) で表される特定構造単位と、前記式(c) で表さ 50 れる共重合性単量体に由来する構造単位とよりなるカル

, )

バゾール系重合体であることが確認された。また、重合体 (A-4) の重量平均分子量Mwは、ゲルバーミエーションクロマトグラフ法(溶媒:テトラヒドロフラン)によるポリスチレン換算で、28000であり、重量平均分子量と数平均分子量との比Mw/Mnは1.65であった。そして、重合体 (A-4) は、特定構造単位を70質量%含有するものであった。

25

【0064】(実施例1)重合体(A-1)1.5部を、テトラクロロエタン100部に溶解させることにより、正孔輸送層形成溶液を調製した。5cm角のガラス 10よりなる透明基板の表面にITO膜(陽極層)が形成されてなる積層材料を用意し、この積層材料におけるITO膜の表面に、調製した正孔輸送層形成溶液を、スピンコーターによって塗布した後、加熱処理による有機溶剤の除去処理を行うことにより、厚みが25nmの正孔輸送層を形成した。次いで、この正孔輸送層上に、真空蒸着法によって厚みが50nmのトリスキノリノラートアルミナムよりなる発光層を形成し、この発光層の表面に、真空蒸着法によって、厚みが200nmで5mm角のマグネシウムおよび銀の合金膜(陰極層)を形成する 20ことにより、図1に示す構成の有機EL素子を製造した

【0065】〈実施例2〉重合体(A-1)の代わりに 重合体(A-2)を用いたこと以外は、実施例1と同様 にして有機EL素子を製造した。

【0066】 (実施例3) 重合体 (A-1) の代わりに 重合体 (A-3) を用いたこと以外は、実施例1と同様 にして有機EL素子を製造した。

【0067】〈実施例4〉重合体(A-1)の代わりに 重合体(A-4)を用いたこと以外は、実施例1と同様 30 にして有機EL素子を製造した。

【0068】 (実施例5) 重合体 (A-1) の代わり

に、重合体(A-2)と、N-ビニルカルバゾールおよび2-(4-ビニルフェニル)-5-ナフチル-1,3.4-オキサジアゾールの共重合体(モル比が9:1で、重量平均分子量(Mw)が19000のもの)とを重量比で1対1となる割合で混合したものを用いたこと以外は、実施例1と同様にして有機EL素子を製造した。この有機EL素子は、その正孔輸送層を構成する全重合体における特定構造単位の割合が50質量%である

【0069】〈比較例1〉重合体(A-1)の代わりに、N-ポリビニルカルパゾールを用いたこと以外は、 実施例1と同様にして比較用の有機EL素子を製造した。

【0070】 〔有機EL素子の評価〕

(1) 発光開始電圧および最高発光輝度:実施例1~実施例5および比較例1に係る有機EL素子の各々に対し、ITO膜をアノードとし、マグネシウムおよび銀の合金膜をカソードとして直流電圧を印加することにより、発光層を発光させ、その最高発光輝度を輝度計「LS-100」(ミノルタ社製)により測定した。また、そのときの発光開始電圧を電圧計「R8240」(ADVANTEST社製)により測定した。

(2) 耐久性:実施例1〜実施例5および比較例1に係る有機EL素子の各々について、印加電流を15mAで一定にした状態で発光層を発光させ、発光開始からその発光輝度が初期の発光輝度の2分の1となるまでの時間(半減期)を測定し、比較例1に係る有機EL素子の半減期を100としたときの相対値(以下、「半減寿命」という。)を求めた。以上、結果を下記表1に示す。

【表1】

[0071]

|                   | 実施例   | 実施例<br>2 | 実施例   | 実施例   | 実施例<br>5 | 比較例<br>1 |
|-------------------|-------|----------|-------|-------|----------|----------|
| 発光開始電圧<br>(V)     | 5. 2  | 4.9      | 5,.9  | 4.8   | 5. 3     | 10. 3    |
| 最高発光輝度<br>(cd/m') | 17000 | 20000    | 12000 | 15000 | 16000    | 6000     |
| 半減寿命              | >1500 | >1500    | >1500 | >1500 | >1500    | 100      |

【0072】表1から明らかなように、実施例1〜実施例5に係る有機EL素子は、比較例1に係る有機EL素子に比べて、発光開始電圧が低く、発光輝度が高く、しかも、優れた耐久性を有するものであることが確認された。

#### [0073]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 発光開始電圧が低く、発光効率が高く、しかも、耐久性 に優れた有機エレクトロルミネッセンス案子を提供する 50 ことができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る有機エレクトロルミネッセンス素子の構成を示す説明用断面図である。

【図2】本発明の第2の実施の形態に係る有機エレクトロルミネッセンス素子の構成を示す説明用断面図である

【図3】本発明の第3の実施の形態に係る有機エレクト

ロルミネッセンス素子の構成を示す説明用断面図である。

【図4】本発明の第4の実施の形態に係る有機エレクトロルミネッセンス素子の構成を示す説明用断面図である。

【図5】本発明の第5の実施の形態に係る有機エレクトロルミネッセンス素子の構成を示す説明用断面図である。

【図6】本発明の第6の実施の形態に係る有機エレクト

ロルミネッセンス素子の構成を示す説明用断面図である。

【符号の説明】

1 透明基板

2 陽極層

3 陰極層

5 直流電源

10 正孔輸送層

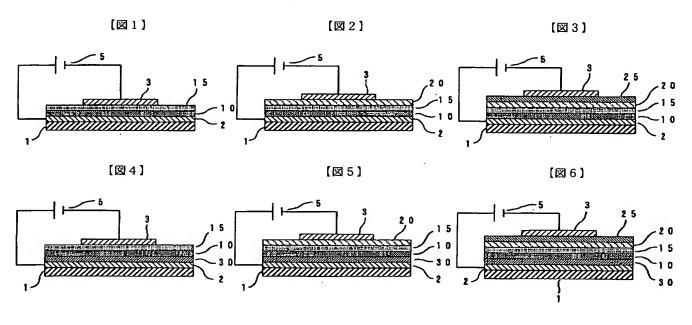
15 発光層

20 電子輸送層

25 電子注入層

30 正孔注入層

**r** 



## フロントページの続き

(51) Int. Cl. '

識別記号

C 0 9 K 11/06

690

H 0 5 B 33/14

FI

テーマコード(参考)

C 0 9 K 11/06 H 0 5 B 33/14 690

(72)発明者 榊原 満彦

東京都中央区築地2丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 安田 博幸

東京都中央区築地2丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 根来 靖典

東京都中央区築地2丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB06 AB11 CA01 CB01

DA01 DB03 EB00

4J100 AB07P AL08P AM21P BA27P

BA37P BC43P BC65P CA01

DA01 DA04 FA03 JA32

. -